

# SEMINAR ANNOUNCEMENT

國立中山大學物理系113學年度第一學期專題演講

## The novel functional logic Max/Min using 1T1R structure and investigation of different gate open process in p-GaN HEMT device

利用1T1R結構實現新穎邏輯Max/Min的  
應用與探討不同閘極製程對pGaN HEMT  
元件之影響

黃煒宸 博士候選人

Mr. Huang, Wei-Chen

國立中山大學物理學系

PhD Candidate, Department of Physics,  
NSYSU

**Time:**

**17 Oct, Thu. 15:10**

**Venue:**

**PH2006**